

RECTIFICATIES

Rectificatie van Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/1922 van de Commissie van 10 oktober 2018 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweërlei gebruik

(Publicatieblad van de Europese Unie L 319 van 14 december 2018)

Bladzijde 129, onder 3B001f., uitlijning van punt 3 en 4:

- in plaats van:*
- ”3. apparatuur die speciaal is ontworpen voor het vervaardigen van maskers, met alle volgende eigenschappen:
 - a. een afgebogen en gefocusseerde elektronen-, ionen- of "laser"-bundels; en
 - b. met één of meer van de volgende eigenschappen:
 - 1. een brandpuntsvlak met een halfwaardebreedte (FWHM) van minder dan 65 nm en een beeldpositionering van minder dan 17 nm (gemiddeld + 3 sigma); of
 - 2. niet gebruikt;
 - 3. en tweede overlay-fout van minder dan 23 nm (gemiddeld + 3 sigma) op het masker;
 - 4. apparatuur die is ontworpen voor toestelverwerking met gebruikmaking van directe schrijfmethode(n), met alle volgende eigenschappen:
 - a. een afgebogen en gefocusseerde elektronenbundel; en
 - b. met één of meer van de volgende eigenschappen:
 - 1. een minimale bundelafmeting van 15 nm of minder; of
 - 2. een overlay-fout van minder dan 27 nm (gemiddeld + 3 sigma);”.
- lezen:*
- ”3. apparatuur die speciaal is ontworpen voor het vervaardigen van maskers, met alle volgende eigenschappen:
 - a. een afgebogen en gefocusseerde elektronen-, ionen- of "laser"-bundels; en
 - b. met één of meer van de volgende eigenschappen:
 - 1. een brandpuntsvlak met een halfwaardebreedte (FWHM) van minder dan 65 nm en een beeldpositionering van minder dan 17 nm (gemiddeld + 3 sigma); of
 - 2. niet gebruikt;
 - 3. en tweede overlay-fout van minder dan 23 nm (gemiddeld + 3 sigma) op het masker;
 - 4. apparatuur die is ontworpen voor toestelverwerking met gebruikmaking van directe schrijfmethode(n), met alle volgende eigenschappen:
 - a. een afgebogen en gefocusseerde elektronenbundel; en
 - b. met één of meer van de volgende eigenschappen:
 - 1. een minimale bundelafmeting van 15 nm of minder; of
 - 2. een overlay-fout van minder dan 27 nm (gemiddeld + 3 sigma);”.
-